

BAV99

硅外延平面二极管芯片 (4 ")

■用途

*用作高压、高速开关应用

■特征:

*较低的正向压降

*耗散功率 225mW

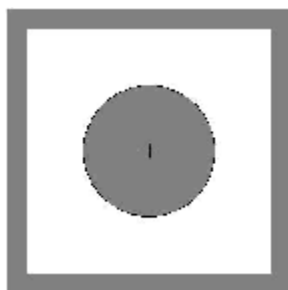
*较小的总电容

*用于片式封装

*较短的反向恢复时间

*有效图形数 90550 只

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	280 μ m×280 μ m
压焊区尺寸	φ 120 μ m
芯片厚度	180±10 μ m
锯片槽宽度	40 μ m
金属层	正面:Al 2.3±10 μ m 背面:Au 1.4±10 μ m

■电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小	最大	典型值	单位
反向电压	V _R	I _R =0.1mA	75		120	V
正向压降	V _F (1)	I _F =1mA		0.65	0.60	V
	V _F (2)	I _F =10mA		0.8	0.72	V
	V _F (3)	I _F =50mA		0.95	0.82	V
	V _F (4)	I _F =150mA		1.2	0.98	V
反向漏电流	I _R	V _R =70V		2.4		μ A
总电容	C _T	V _R =0, f=1MHZ		3.0	2.0	PF
反向恢复时间	trr	I _F =I _R =10mA I _{rr} =0.1×I _R		6.0		ns